

Vergleichsliste für Dioden DDR/international

DDR-Typ	Vergleichstyp	Beschreibung	DDR-Typ	Vergleichstyp	Beschreibung
GA 100	AA 131	Ge-Universaltyp 20 V	SY 320/0,75	BY 188/196	Si-Gleichrichterioden kleiner Leistung 950 mA im Kunststoffgehäuse mit Drahtanschlüssen
GA 101	AA 119	Ge-Universaltyp 40 V	SY 320/1	BYX 36/1	
GA 102	AA 134	Ge-Universaltyp 60 V	SY 320/2	BY 197/201/2	Si-Gleichrichterioden kleiner Leistung 950 mA im Kunststoffgehäuse mit Drahtanschlüssen
GA 104	AA 117/118	Ge-Universaltyp 110 V	SY 320/3	BYX 36/2	
GA 105	AA 130	Ge-Gleichrichterdiode	SY 320/4	BY 198/201/3	Si-Gleichrichterdiode 290...480 mA
GAY 61	FD 4	Ge-Universaltyp 100 mA	SY 320/5	BYX 55/3	
GAY 64	FD 7	Ge-Universaltyp 80 V	SY 320/6	BY 201/4	Schnelle Si-Gleichrichterioden 1,1...1,4 A
SA 412	BA 177/182/243	Si-Epitaxie-Schaltdiode	SY 320/8	BY 201/5	
SA 415	BA 218	Si-Epitaxie-Schaltdiode	SY 320/10	BYX 55/5	Si-Gleichrichterdiode 0,53...0,73 mA
SA 418	BA 219	Universelle Si-Epitaxie-Dioden	SY 320/8	BY 199/201/6	
	BAY 61		SY 320/10	BYX 36/4	Si-Gleichrichterdiode 290...480 mA
SAY 12	BA 204	Si-Planar-Epitaxie-Typen 300 mA im Plastgehäuse	SY 320/8	BY 204/8	
	BAV 18/76	im Plastgehäuse	SY 320/10	BY 204/10	Schnelle Si-Gleichrichterioden 1,1...1,4 A
	BSW 76	Bauform L 2/13 oder B	SY 330	BYX 10	
	BAY 42		SY 345	BY 203	Si-Gleichrichterdiode 290...480 mA
SAY 16	BA 220	Si-Planar-Epitaxie-Typen 300 mA mit geringer Sperrerrholungszeit	SY 345	BY 113/143/198	
	BAY 17		SY 347	BYX 55/600	Schnelle Si-Gleichrichterioden 1,1...1,4 A
	BAY 41		SY 351	1 P 643	
SAY 17	BA 108/147	Si-Planar-Epitaxie-Typen 175 mA	SY 351	BY 226/251	Si-Gleichrichterdiode 0,53...0,73 mA
	BAY 38/95		SY 356	BYX 258	
SAY 18	BA 108/147	Si-Planar-Epitaxie-Typen 175 mA	SY 360/05	1 N 4001	Si-Gleichrichterdiode 3 A
SAY 20	BAY 93	Si-Planar-Epitaxie-Typ 75 mA	SY 360/1	BYX 258	
SAY 30	BA 216	Si-Planar-Epitaxie-Typ 25 V	SY 360/2	1 N 4002	Si-Gleichrichterdiode 1,1...1,5 A
	1 N 385		SY 360/3	1 N 4003	
SAY 32	BA 217	Si-Planar-Epitaxie-Typen 25 V	SY 360/4	1 N 4004	Si-Gleichrichterioden 950 mA kleiner Leistung im Miniatur-Plastgehäuse
	BAY 32		SY 360/6	1 N 4005	
	1 N 813		SY 360/8	1 N 4006	Si-Gleichrichterdiode 290...480 mA
SAY 40	BA 116	Si-Planar-Epitaxie-Typ 15 V	SY 360/10	1 N 4007	
SAY 42	BAW 75	Si-Planar-Epitaxie-Typen 15 V	SY 361/10	1 N 4007	Si-Gleichrichterdiode 1 A kleiner Leistung
	BAY 52		SY 361/13	1 N 4007	
	1 N 138		SY 710	BAW 29	Si-Gleichrichterdiode 7 A
SY 170	SSiE 12	Si-Gleichrichterdiode 25 A	SY 715	BVY 79	
SY 171	BYX 21/1	Si-Gleichrichterioden 25 A im Preßfit-Gehäuse	SZ 600/0,75	BZV 40...C 200	Si-Gleichrichterdiode 12 A
	BYX 21/2	Katode am Gehäuse	...22	BZX 67...C 22	
	SSiE 11	Katode am Gehäuse	...22	BZY 95C10...22	Si-Z-Dioden 3,5/8 W im Metallgehäuse
SY 201	BYY 31	Si-Gleichrichterioden mittlerer Leistung 2 A	SZX 18/1	ZX 5,1...22	
	SSiC 0810		...22	BZX 55C6V5...C 22	Z-Dioden 500 mW in Allglasausführung
SY 202	BYY 88		...22	BZY 83C2V7...C 22	
	SSiC 0820		...22	BZY 85C2V7...C22	Z-Spannungstoleranz 5 %
SY 203	BYY 32		SZX 19/5,1	ZPD 1...22	
SY 204	BYY 33		...24	BZX 55C6V5...C 24	Z-Dioden 500 mW in Allglasausführung
SY 205	BYY 34		...24	BZX 83C2V7...C 24	
	SSiC 0840		...24	BZX 85C2V7...C 24	Z-Spannungstoleranz 5 %
SY 206	BYY 35		SZX 21/1	ZPD 5,1...24	
SY 207	BYY 36		...24	BZX 55C0V8...C 24	Z-Dioden 250/400 mW im Plastgehäuse
	SSiC 0860		...24	BZX 55C2V4...C 24	
SY 208	BYY 37		...24	BZX 79C4V7...C 24	Z-Spannungstoleranz 5 %
SY 210	SSiC 0880		...24	BZX 97C0V8...C 24	

Hinweise

- Die Zusammenstellung erfolgte auf Grundlage von [1] und [2]; Hersteller blieben unberücksichtigt.
- Einige Leistungsdioden wurden zugunsten der von HF- und Computertastlern noch gern benutzten Ge-Universaltypen nicht angeführt, obwohl Vergleichstypen existieren.
- Die Werte in V bzw. (m)A betreffen Sperrgleichspannung bzw. Dauerstrom des DDR-Typs.
- Beim Austausch von Leistungsdioden empfiehlt sich eine Datenüberprüfung in z. B. [3] und [4]. Es kann vorkommen, daß der Vergleichstyp

Sperrgleichspannung oder Dauerstrom des DDR-Typs nicht erreicht.

- Wird ein DDR-Typ ohne die die Sperrspannung kennzeichnende Zahl bzw. Ziffer nach dem Schrägstrich genannt, ist der Vergleichstyp für viele dieser Typen geeignet. Eine Datenüberprüfung sollte vorgenommen werden.
- Die Typen SY 320 können ebenfalls durch 1 N 4001...4007 ersetzt werden, vgl. SY 360.

Literatur

- Halbleiter-Bauelemente, RFT-Katalog des Kombinars Mikroelektronik
- Negssoeg, S.: Dioden-Vergleichs-Handbuch, Teil 1: A-Z, Verlag für technische Literatur, Hirschau 1986
- Streng, K. K.: Diodendaten, Militärverlag der DDR, Berlin 1977
- Grallert, L.: Diodenvergleichsliste, Amateurreihe „electronica“, Band 247, Militärverlag der DDR, Berlin 1990